平成21年度採択分 平成24年4月10日現在

スピン偏極パルスTEMの開発とナノスピン解析への応用 Development of the spin polarization pulsed EM, and application to nano-spin analysis

田中信夫(TANAKA NOBUO)

名古屋大学・エコトピア科学研究所・教授



研究の概要

次世代磁気デバイス開発の鍵となるナノスピン解析用のスピン偏極 TEM を開発し、磁気量子
ドット内のスピン状態の高分解能観察をはじめ、ナノ磁性に関する先端的研究をする。
このためにスピン偏極TEMを、電子銃開発、スピン回転器・注入器、磁場印加試料ホルダー、
磁気散乱理論の開発項目などに分けて進め、かつその応用研究を5年間で実施する。
研 究 分 野:複合新領域
科研費の分科・細目 : ナノ・マイクロ科学 ナノ構造科学
キ ー ワ ー ド:電子顕微鏡・スピンエレクトロニクス・量子ビーム

1. 研究開始当初の背景

近年の磁気記録装置の高密度化への過酷 な要求は、磁気記録単位を5nm以下にするこ とを必須とし、それに対応する磁気量子ドッ トの歩止まりの高い製造とその磁気状態の 正確な評価を要求している。TEMで磁性状態 の観察を行う方法の一つとして、スピン偏極 電子ビームの利用が考えられる。近年、名古 屋大学において、GaAs半導体歪超格子構造を ベースとした高性能フォトカソードが開発 され、90%のスピン偏極度とLaB₆熱電子源よ りもさらに一桁高い輝度 1.0×10⁷ A m⁻² sr⁻¹ V⁻¹ をすでに実現している。

2. 研究の目的

スピン偏極電子線を用いた高分解能 TEM を世界で初めて開発する。それを用いて次世 代大容量 HDD 用に開発する FePt などのナ ノサイズ磁気量子ドットのスピン構造やト ンネル磁気抵抗(TMR)素子内の磁化反転現 象を精緻に研究する。さらに分解能が 1nm 以下に達した段階で、各種スピントロニクス デバイスの素子性能を支配する界面スピン 構造を原子レベルで可視化し、新しいナノス ピン解析技術の開発に役立てることも目的 としている。

3. 研究の方法

本研究は世界で初めての装置開発と測定 実験を含むため、以下の5年間の計画で研究 を進める。本研究はこれを次の7つの部分に 分割して、綿密な研究開発設計をしている。

それぞれの内容は、(1)高輝度・高偏極度フ オトカソード開発、(2)30-50keVのTEM用偏 極電子銃の開発(図1,2参照)、(3)スピン回 転器およびTEMへの入射最適化設計および 装置開発、(4)光または磁場、電場励起用試料 ホルダー部および対物レンズ部の開発、(5) 偏極電子による像の高感度・高精度記録法、 および磁気状態を取り出す画像処理装置の 開発、(6)種々の磁性関係薄膜、ナノワイヤー 微粒子の作製法の開発と観察、(7)電子のスピ ンによる磁気ポテンシャルによる電子線の 散乱の理論的研究である。最終的にこれらを 統合し、スピン偏極電子線を用いた高分解能 スピン構造観察を実現する。

4. これまでの成果

TEM用に50keV偏極電子源の設計・作製を 行い、スピン偏極電子線の発生に成功した。 また、この成功によりスピン偏極電子線を TEMへ注入することを可能にした。全体計 画の心臓部である本開発は、計画通りに成 功した。また、新たにスピン回転器の設計 製作を行い、電子スピンの制御を行うこと を可能にした。また、照射系についても新 規にダブルギャップレンズを開発し、スピ ン方向を正確に制御しながら試料に照射す ることを可能にした。

一方、スピン偏極電子銃用・背面照射型 フォトカソードの開発では、GaAs-GaAsP歪 み超格子を活性層に使用しつつ、中間層を AlGaAsに変える等の工夫を施すことにより 向上を図った。結果、偏極度90%を保った まま量子効率を0.4%へと従来型の4倍に向 上することに成功した。これにより、顕微 鏡における輝度の向上、長期安定動作を可 能にする重要な成果を得た。

また、これら新規に開発したスピン偏極 電子銃とスピン回転器を含む照射系ならび にTEM本体の結合に成功し、さらに、スピ ン偏極電子線をスピン回転器、CL、TEM 本体、そして観察室まで輸送することに成 功した。本内容は平成24年度の前半に実 施されるべき内容であり、当初計画より早 く進んでいる。

5. 今後の計画

電気的安定性を10⁻⁶に、真空度を10⁻⁷Paに、 また差動排気系をより多段にした電圧可変 20kV-100kVのTEMにスピン偏極電子銃を取 り付ける。その後、透過電子回折図形や像を スピンごとに画像処理してスピン依存散乱 過程を抽出する。

磁性ドット試料に電子顕微鏡のレンズに 必要な強磁場をかけないために、レンズギャ ップ付近の磁場をミリガウスオーダーにし たローレンツレンズも用いる。これにより、 スピン偏極電子銃から取り出した高スピン 偏極電子を Fe-Pt 量子ドットやハーフメタル ナノ積層構造にパルス注入することにより、 磁場を用いないスピン注入磁化反転ダイナ ミクスをスピン偏極 TEM で観察する。また、 スピン偏極 TEM を用いて各種ナノ構造磁性 体のスピン構造解析を行う。

6. これまでの発表論文等(受賞等も含む)

- 1. M Kuwahara, et al., Journal of Physics: Conference Series, 掲載 確定
- 2. N. Sugimoto, et al., J. Magn. Soc. Jpn., (2012) accepted.
- Koh Saitoh, et al., Journal of Electron Microscopy, (2012) doi: 10.1093/jmicro/dfs036.
- S. Morishita, J. Yamasaki, and N. Tanaka, Journal of Electron Microscopy, 60(2) (2011) 101-108
- N. Fukatani, K. Ueda and H. Asano, Jpn. J. Appl. Phys., 109 (2011) 073911-1-6.
- 6. T. Miyawaki, et al., *IEEE Trans.* on Mag., **47** (2011) 2643-2645.
- H. Matsushima, et al., Jpn. J. Appl. Phys., 50 (2011) 103004-1-5.
- 8. S. Inamoto, et al., Philosophical Magazine Letters, 91(9) (2011) 632-639.
- 9. Y. Ishibashi, et al., Philosophical Magazine Letters, 91 (2011) 2519-2527.
- 10. M. Kuwahara, et al., Journal of Physics: Conference Seriese, 298 (2011) 012016.
- 11. R. A. Herring, et al., Journal of Electron Microscopy.
- 12. K. Yoshida, et al., Microscopy and Microanalysis, 17 (2011) 264-273.

ホームページ等 http://sirius.cirse.nagoya-u.ac.jp/